

2SA1553

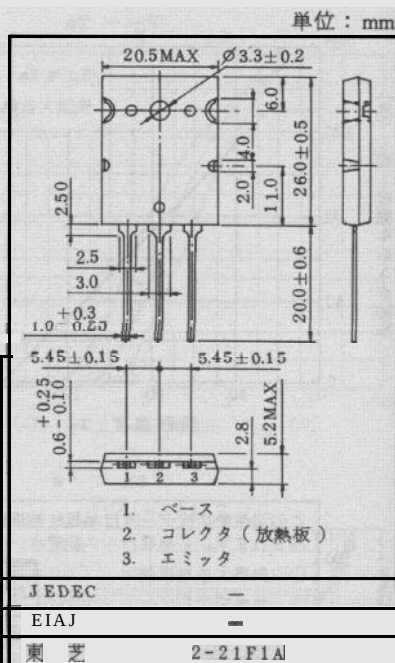
シリコンPNP三重拡散形トランジスタ

○ 電力増幅用

- ・ 高耐圧です。: $V_{CEO} = -230V$ (最小)
- ・ 2SC4029 とコンプリメンタリになります。
- ・ 120 W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-230	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-230	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-15	A
ベース電流	I_B	-1.5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	150	W
接 合 温 度	T_j	150	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ C$



電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -230V, I_E = 0$	—	—	-5.0	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-5.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -50mA, I_B = 0$	-230	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	55	—	160	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5V, I_C = 7A$	35	60	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -8A, I_B = -0.8A$	—	-1.5	-3.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -7A$	—	-1.0	-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	—	25	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	470	—	pF

注 1 $h_{FE(1)}$ 分類 R: 55-110, Q: 80-160

